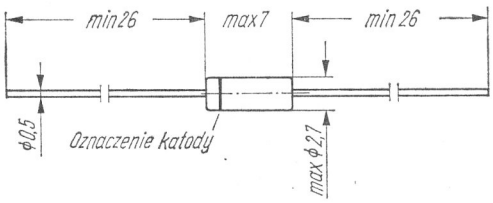


Rys. 2-90. BY35

Typ diody: dioda krzemowa

Firma: ITT

Wykonanie: dioda krzemowa planarna, pojemnościowa w obudowie DO-7, bardzo duża rezystancja przy małych napięciach, w zakresie małych prądów przewodzenia logarytmiczny przebieg krzywej przewodzenia, ciężar około 0,2 G

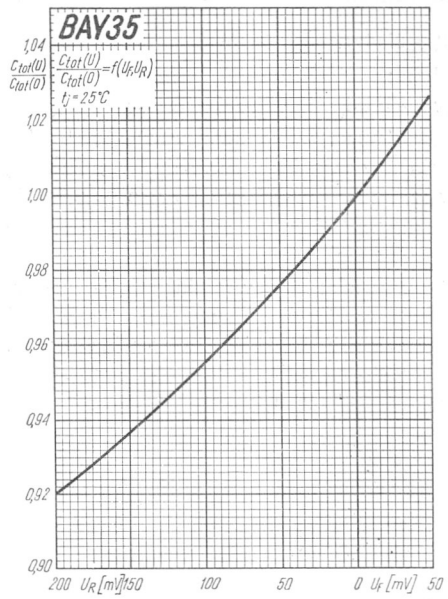
Zastosowanie: układy modulacyjne o bardzo dużej rezystancji do przetwarzania napięć stałych rzędu kilku mV na napięcia zmienne, wzmacniacze napięcia stałego o rezystancji wewnętrznej rzędu tysięcy MΩ

Wartości charakterystyczne[1)]

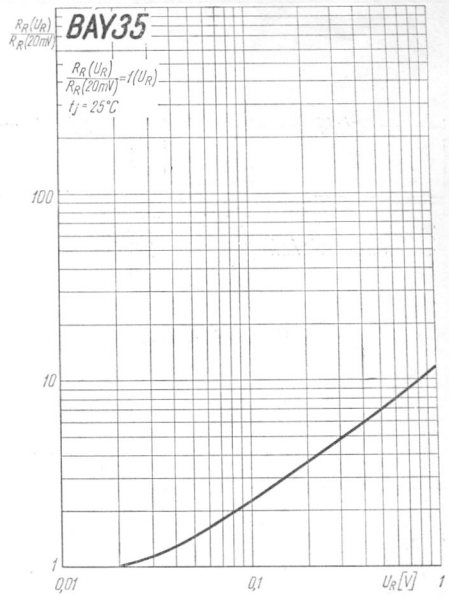
	min	typ	max		
C_{tot}[2)]	80	100	120	pF	przy $U_F = U_R = 0$
$\frac{dC}{CdU} \cdot 100$		44		$\frac{\%}{V}$	przy $U_F = U_R = 0$
R_F	20			GΩ	przy $U_F = 20$ mV
R_R	20			GΩ	przy $U_R = 20$ mV
r_s		0,6		Ω	przy $U_F = U_R = 0$
$U_{(BR)R}$	5			V	

1) $t_j = 25°C$

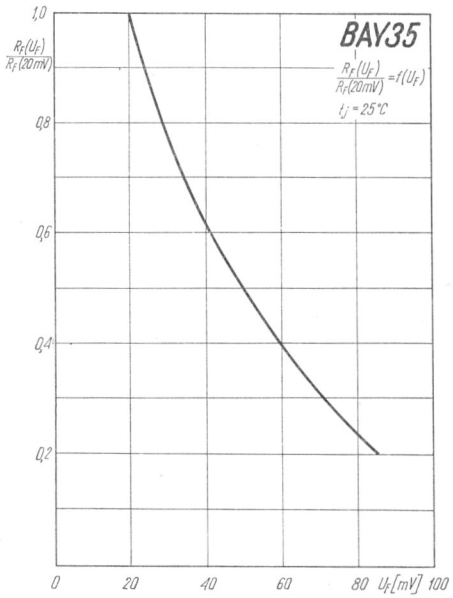
2) maksymalna różnica między wartościami pojemności pary diod BAY35 wynosi 5 pF



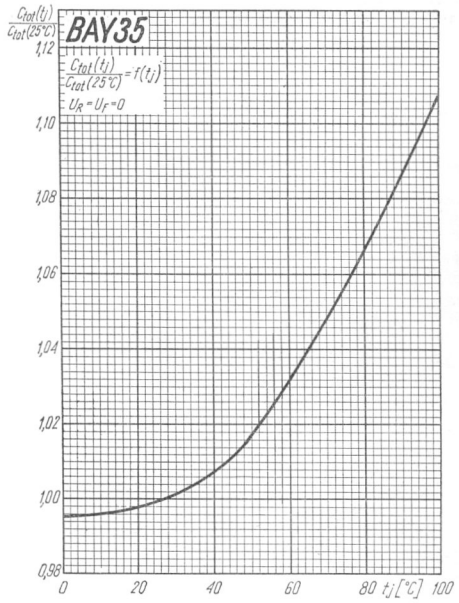
Rys. 2-91. Zależność pojemności całkowitej od napięcia diody



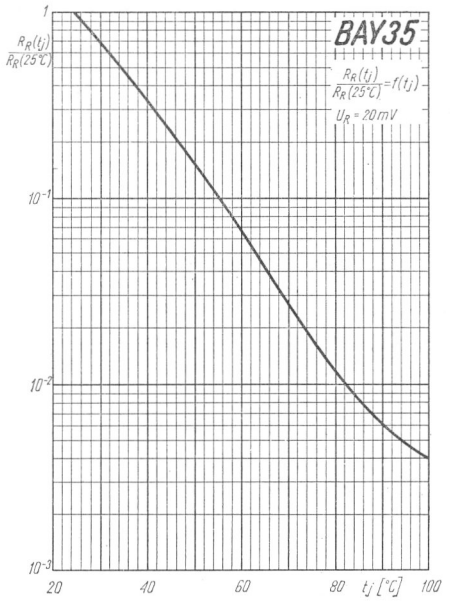
Rys. 2-92. Zależność wartości względnej rezystancji w kierunku zaporowym od napięcia wstecznego



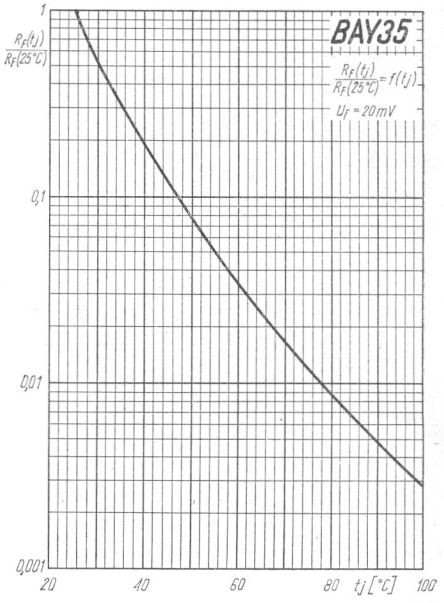
Rys. 2-93. Zależność wartości względnej rezystancji w kierunku przewodzenia od napięcia przewodzenia



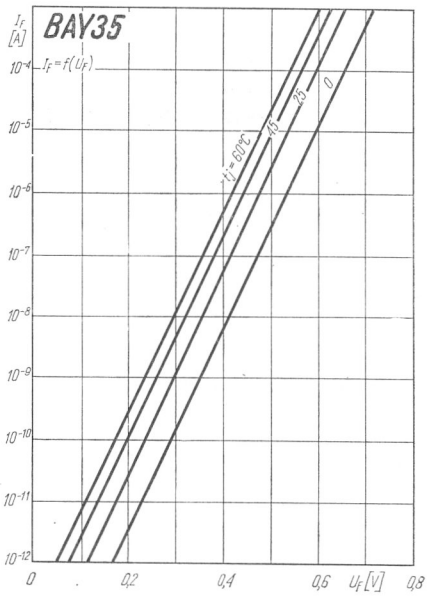
Rys. 2-94. Zależność wartości względnej pojemności całkowitej od temperatury złącza



Rys. 2-95. Zależność wartości względnej rezystancji w kierunku zaporowym od temperatury złącza



Rys. 2-96. Zależność wartości względnej rezystancji w kierunku przewodzenia od temperatury złącza



Rys. 2-97. Charakterystyka prądu przewodzenia